PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05161390 A

(43) Date of publication of application: 25.06.93

(51) Int. CI	H02P 7/288		
(21) Application number: 03030881		(71) Applicant:	MITSUBISHI DENKI ENG KKMITSUBISHI ELECTRIC CORP
(22) Date of filing: 26.02.91		(72) Inventor:	KUSAKA SATOSHI

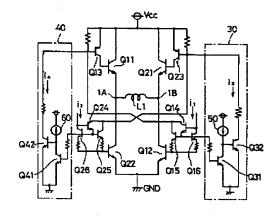
(54) DRIVE CIRCUIT OF MOTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the generation of a parasitic transistor at the time of switching a coil current.

CONSTITUTION: When lower switching elements Q12, Q22 are reversed to OFF state, rotation characteristics stabilization circuits 30, 40 detect the reversion to reverse upper switching elements Q21, Q11, which have been placed in the OFF state till then, to ON state. Thus, because falling of the output terminals 1A, 1B of an armature coil L1 below a ground potential is avoided and the generation of a parasitic transistor is hindered even if a counter-electromotive force is generated with the interruption of a coil current, it is possible to eliminate uneven rotation to rotate a motor smoothly.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平5-161390

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 2 P 7/288

C 4238-5H

G 4238-5H

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平3-30881

(22)出願日

平成3年(1991)2月26日

(71)出願人 591036457

三菱電機エンジニアリング株式会社 東京都千代田区大手町 2丁目 6番 2号

(74)上記1名の代理人 弁理士 大岩 増雄

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(74)上記1名の代理人 弁理士 大岩 増雄 (外2名

(72) 発明者 日下 智

伊丹市東野四丁目61番 5号 三菱電機エン ジニアリング株式会社エル・エス・アイ設

計センター内

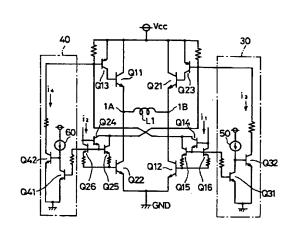
(54)【発明の名称】 モータ駆動回路

(57)【要約】

【目的】コイル電流の切り換え時に寄生トランジスタが 発生することを無くす。

【構成】下側スイッチング素子Q12(Q22)をOF F状態に反転したときに、回転特性安定化回路30(4 0)がその反転を検出してそれまでOFF状態であった 方の上側スイッチング素子Q21(Q11)をON状態 に反転する。、

【効果】コイル電流の遮断に伴って逆起電力が発生して も、電機子コイルL1の出力端子1A(1B)がグラン ド電位よりも下回ることを回避して寄生トランジスタの 発生を阻止するので、回転むらをなくしてモータを滑ら かに回転させることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ブリッジを構成する4個のスイッチング 素子のうち一方の対をなす上側スイッチング素子および 下側スイッチング素子をONにしかつ他方の対をなす上 側スイッチング素子および下側スイッチング素子をOF Fにする状態と、前記一方の対をなす上側スイッチング 素子および下側スイッチング素子をOFFにしかつ前記 他方の対をなす上側スイッチング素子および下側スイッ チング素子をONにする状態とを交互に切り換えること により電機子コイルに対して正方向電流と逆方向電流と を交互に流すようにしたモータ駆動回路において、ON 状態にある下側スイッチング素子がOFF状態に反転し たときに、その反転を検出してそれまでOFF状態にあ った方の上側スイッチング素子をON状態に反転する回 転特性安定化回路を付加したことを特徴とするモータ駆 動回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、電機子コイルに対す る出力段として4個のスイッチング素子をブリッジに配 20 置してなるモータ駆動回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図3は、従来のこの種の2相のモータ駆 動回路を示す回路図である。

【0003】図において、L1は電機子コイル、1A, 1 Bは電機子コイルL1に対するモータ駆動回路の出力 端子、Q11,Q21は出力上側スイッチング素子、Q 12, Q22は出力下側スイッチング素子、Q13~Q 16, Q23~Q26はバイアス用のスイッチング素 子、i1, i2 はバイアス電流である。出力上側スイッ チング素子Q11と出力下側スイッチング素子Q12と は一方の対をなしており、出力上側スイッチング素子Q 21と出力下側スイッチング素子Q22とは他方の対を なしている。

【0004】次に、このモータ駆動回路の動作を図4に 示したタイミングチャートに従って説明する。

【0005】バイアス電流i」が流れるときはバイアス 電流 i 2は流れず、逆にバイアス電流 i 2 が流れるとき はバイアス電流 i 1 が流れないように制御される。ま ず、バイアス電流i1が流れると、スイッチング素子Q 14,Q15,Q16がONして出力下側スイッチング 素子Q12がONするとともに、スイッチング素子Q1 3もONして出力上側スイッチング素子Q11がONす る。このときバイアス電流 i2 は流れないから、出力上 側スイッチング素子Q21および出力下側スイッチング 素子Q22はともにOFFとなっている。

【0006】したがって、電機子コイルL1に対して は、直流電源Vcc→出力上側スイッチング素子Q11→ 出力端子1A→電機子コイルL1→出力端子1B→出力 コイル電流が正方向に流れ、出力端子1Aは"H"レベ ルに、出力端子1Bは"L"レベルになる。

【0007】上記とは逆に、バイアス電流i2が流れる と、スイッチング素子Q24, Q25, Q26がONし て出力下側スイッチング素子Q22がONするととも に、スイッチング素子Q23もONして出力上側スイッ チング素子Q21がONする。このときバイアス電流i 1 は流れないから、出力上側スイッチング素子Q11お よび出力下側スイッチング素子Q12はともにOFFと なっている。したがって、電機子コイルL1に対して は、直流電源Vcc→出力上側スイッチング素子Q21→ 出力端子1B→電機子コイルL1→出力端子1A→出力 下側スイッチング素子Q22→グランドGNDの経路で コイル電流が逆方向に流れ、出力端子1 Bは"H"レベ ルに、出力端子1Aは"L"レベルになる。

【0008】 つまり、バイアス電流 i1, i2 の交互切 り換えによって、一方の対をなす出力上側スイッチング 素子Q11および出力下側スイッチング素子Q12をO Nにしかつ他方の対をなす出力上側スイッチング素子Q 21および出力下側スイッチング素子Q22をOFFに する状態と、前記一方の対をなす出力上側スイッチング 素子Q11および出力下側スイッチング素子Q12をO FFにしかつ前記他方の対をなす出力上側スイッチング 素子Q21および出力下側スイッチング素子Q22をO Nにする状態とを交互に切り換えることにより、電機子 コイルL1に対してコイル電流を正方向に流す状態と逆 方向に流す状態とを交互に切り換えてモータを回転させ るのである。

【0009】なお、出力端子1Aに対する上下のスイッ チング素子Q11, Q22が同時にONしたり、出力端 子1Bに対する上下のスイッチング素子Q21, Q12 が同時にONしたりすると、直流電源VccとグランドG NDとの間が短絡状態となって電機子コイルL1に電流 が流れなくなるため、両バイアス電流 i1, i2 が同時 には流れないように工夫されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】図4に示すように、両 バイアス電流i1 , i2 がともに出力されない期間 t_1 , t_2 が存在する。期間 t_1 は、バイアス電流 i_1 の立ち下がりからバイアス電流 i2 の立ち上がりまでで あり、期間t2 は、バイアス電流i2 の立ち下がりから バイアス電流 i1 の立ち上がりまでである。これらの期 間 t1, t2 においては4つの出力スイッチング素子Q 11, Q12, Q21, Q22のすべてがOFFとな

【0011】そして、期間 t1 の開始初期であるバイア ス電流 i 1 の立ち下がりのタイミングにおいて、電機子 コイルL1に逆起電力が発生し、それまで直流電源Vcc と実質的に同電位であった出力端子1 AがグランドGN 下側スイッチング素子Q12→グランドGNDの経路で 50 Dの電位を下回る電位となり、かつ、それまでグランド

GNDと実質的に同電位であった出力端子1Bが直流電源Vccの電位を上回ることになる。

【0012】また、期間 t2の開始初期であるバイアス電流 i2の立ち下がりのタイミングにおいて電機子コイルL1に発生する逆起電力によって、それまでグランドGNDと実質的に同電位であった出力端子1Aが直流電源Vccの電位を上回る電位となり、かつ、それまで直流電源Vccと実質的に同電位であった出力端子1BがグランドGNDの電位を下回ることになる。

【0013】つまり、出力下側スイッチング素子Q22(Q12)がOFFである期間において、出力上側スイッチング素子Q11(Q21)がON状態からOFF状態に反転すると、出力端子1A(1B)がグランドGNDの電位を下回る。その結果として、ICの内部に寄生トランジスタが発生することになる。

【0014】寄生トランジスタは、これを例えばNPN型とすると、そのエミッタが出力端子1A(1B)に、ベースがグランドGNDにそれぞれ接続され、コレクタがICのいずれかの箇所に接続されたものとなる。出力端子1A(1B)がグランドGNDの電位を下回ることでエミッタ電位がベース電位よりも低くなって寄生トランジスタが導通し、寄生トランジスタのコレクタがつながっているICの部分の電位、特に出力スイッチング素子Q11、Q12、Q21、Q22の近傍のバイアス回路のトランジスタの電位を一瞬ではあるが規定電位よりも低い側に引っ張ったり、あるいは、各スイッチング素子への電源供給を一瞬遮断したりすることになる。そして、そのため、モータの回転数ートルク特性に変動が生じ、モータの滑らかな回転を阻害するという回転むらの不具合を引き起こす問題があった。

【0015】この発明は、上記のような問題点を解消するために創案されたものであって、寄生トランジスタに起因した回転むらを起こさせずにモータを滑らかに回転させることができるモータ駆動回路を得ることを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】この発明は、ブリッジを構成する4個のスイッチング素子のうち一方の対をなす上側スイッチング素子および下側スイッチング素子をONにしかつ他方の対をなす上側スイッチング素子および下側スイッチング素子をOFFにする状態と、前記一方の対をなす上側スイッチング素子および下側スイッチング素子および下側スイッチング素子および下側スイッチング素子をONにする状態とを交互に切り換えることにより電機子コイルに対して正方向電流と逆方向電流とを交互に流すようにしたモータ駆動回路において、ON状態にある下側スイッチング素子がOFF状態に反転したときに、その反転を検出してそれまでOFF状態にあった方の上側スイッチング素子をON状態に反転する回転特性安定化回路を付加し

たことを特徴とするものである。

[0017]

【作用】電機子コイルに流れる電流の方向を切り換えるためにON状態にある下側スイッチング素子をOFF状態に反転すると、回転特性安定化回路がその反転を検出し、その検出に基づいてそれまでOFF状態にあった方の上側スイッチング素子をON状態に反転するから、電機子コイルの両端はともにON状態となった2つの上側スイッチング素子を介してつながれることになるため、コイル電流の遮断に伴って逆起電力が発生しても電機子コイルへの出力端子がグランドGNDの電位よりも下回るといった事態を免れ、寄生トランジスタの発生を阻止できる。

[0018]

【実施例】図1は、本発明の一実施例に係る2相のモータ駆動回路を示す回路図である。このモータ駆動回路はIC(集積回路)で構成されている。

【0019】スイッチング素子Q13, Q23はPNP 型のトランジスタで構成され、それ以外のスイッチング 素子はNPN型のトランジスタで構成されている。出力 上側スイッチング素子Q11(Q21)は、コレクタが 直流電源Vccに、ベースがスイッチング素子Q13(Q 23) のコレクタに、エミッタが電機子コイルL1に対 する出力端子1A(1B)にそれぞれ接続されている。 スイッチング素子Q13(Q23)は、エミッタが出力 上側スイッチング素子Q11(Q21)のコレクタに、 ベースがスイッチング素子Q14, Q15 (Q24, Q 25) のコレクタにそれぞれ接続されている。 スイッチ ング素子Q14(Q24)は、ベースがバイアス電流i 30 1 (i2)の入力端子およびスイッチング素子Q16 (Q26) のコレクタに接続され、エミッタがスイッチ ング素子Q15, Q16 (Q25, Q26) のベースに 接続されている。スイッチング素子Q15, Q16 (Q 25, Q26)の各エミッタは出力下側スイッチング素 子Q12(Q22)のベースに接続されている。出力下 側スイッチング素子Q12(Q22)は、コレクタが電 機子コイルL1の出力端子1B(1A)に、エミッタが グランドGNDにそれぞれ接続されている。以上説明し た回路構成は従来例と同様である。

【0020】本実施例においては、上記の回路構成に加えて上下の4つのブリッジを構成している出力スイッチング素子Q11,Q12,Q21,Q22が同時にOFFすることを防止するための回転特性安定化回路30,40が設けられている。回転特性安定化回路30(40)は、スイッチング素子Q31,Q32(Q41,Q42)を備えている。スイッチング素子Q31(Q41)は、コレクタが定電流源50(60)およびスイッチング素子Q32(Q42)のベースに、ベースがスイッチング素子Q15,Q16(Q25,Q26)のベースに、エミッタがグランドGNDにそれぞれ接続されて

5.

いる。そして、スイッチング素子Q32(Q42)は、 コレクタがスイッチング素子Q23 (Q13) のベース およびスイッチング素子Q24 (Q14) のコレクタ に、エミッタがグランドGNDにそれぞれ接続されてい る。

【0021】次に、このモータ駆動回路の動作を図2に 示したタイミングチャートに従って説明する。

【0022】バイアス電流i1が流れるときはバイアス 電流 i 2は流れず、逆にバイアス電流 i 2 が流れるとき はバイアス電流ii が流れないように制御される。

【0023】 ① バイアス電流 i 1 が流れる期間の動作 バイアス電流i1 が流れると、スイッチング素子Q1 4, Q15, Q16がONして出力下側スイッチング素 子Q12がONする。

【0024】バイアス電流i2が流れていないから回転 特性安定化回路40におけるスイッチング素子Q41は OFFであり、スイッチング素子Q42のベースが定電 流源60によって "H" レベルとなるためこのスイッチ ング素子Q42がONとなり、コレクタ電流i4がグラ ンドGNDに流れ込むため、PNP型のスイッチング素 20 子Q13のベースが "L" レベルとなってこのスイッチ ング素子Q13がONし、出力上側スイッチング素子Q 11がONする。

【0025】同時に、スイッチング素子Q14のONに よって回転特性安定化回路30におけるスイッチング素 子Q31がONするため、スイッチング素子Q32のベ ース電圧が "L" レベルとなってスイッチング素子Q3 2がOFFとなり、それのコレクタ電流i3 は遮断状態 となる。コレクタ電流 i 3は、バイアス電流 i 1 を論理 的に否定(反転)したものとなる。そのため、スイッチ ング素子Q23のベースは、スイッチング素子Q32に よっては "L" レベルとはならない。

【0026】そして、このときバイアス電流 i2 は流れ ないから、スイッチング素子Q24はOFFであり、P NP型のスイッチング素子Q23もそのベースが直流電 源Vccによって"H"レベルであるためOFFであり、 出力上側スイッチング素子Q21はOFFとなってい る。また、スイッチング素子Q25, Q26がOFFで あることから出力下側スイッチング素子Q22もOFF である。

【0027】上記の出力上側スイッチング素子Q11と 出力下側スイッチング素子Q12のONによって、電機 子コイルL1に対しては、直流電源Vcc→出力上側スイ ッチング素子Q11→出力端子1A→電機子コイルL1 →出力端子1B→出力下側スイッチング素子Q12→グ ランドGNDの経路で正方向にコイル電流が流れ、出力 端子1Aは"H"レベルに、出力端子1Bは"L"レベ ルになる。

【0028】 ② バイアス電流 i2 が流れる期間の動作 次に、期間 t 1 , t 2 を除いたタイミングにおいて、上 50 2 をOFFにしかつ前記他方の対をなす出力上側スイッ

記とは逆にバイアス電流 i2 が流れ、かつ、バイアス電 流11が流れていない状態での動作は次のようになる。 バイアス電流i2が流れると、スイッチング素子Q2 4, Q25, Q26がONして出力下側スイッチング素 子Q22がONする。

【0029】バイアス電流i1が流れていないから回転 特性安定化回路30におけるスイッチング素子Q31は OFFであり、スイッチング素子Q32のベースが定電 流源50によって "H" レベルとなるためこのスイッチ ング素子Q32がONとなり、コレクタ電流i3 がグラ ンドGNDに流れ込むため、PNP型のスイッチング素 子Q23のベースが "L" レベルとなってこのスイッチ ング素子Q23がONし、出力上側スイッチング素子Q 21がONする。

【0030】同時に、スイッチング素子Q24のONに よって回転特性安定化回路40におけるスイッチング素 子Q41がONするため、スイッチング素子Q42のベ ース電圧が "L" レベルとなってスイッチング素子Q4 2がOFFとなり、それのコレクタ電流i4 は遮断状態 となる。コレクタ電流 i 4は、バイアス電流 i 2 を論理 的に否定(反転)したものとなる。そのため、スイッチ ング素子Q13のベースは、スイッチング素子Q42に よっては "L" レベルとはならない。

【0031】そして、このときバイアス電流 i 1 は流れ ないから、スイッチング素子Q14はOFFであり、P NP型のスイッチング素子Q13もそのベースが直流電 源Vccによって "H" レベルであるためOFFであり、 出力上側スイッチング素子Q11はOFFとなってい る。また、スイッチング素子Q15,Q16がOFFで あることから出力下側スイッチング素子Q12もOFF

【0032】上記の出力上側スイッチング素子Q21と 出力下側スイッチング素子Q22のONによって、電機 子コイルL1に対しては、直流電源Vcc→出力上側スイ ッチング素子Q21→出力端子1B→電機子コイルL1 →出力端子1A→出力下側スイッチング素子Q22→グ ランドGNDの経路で逆方向にコイル電流が流れ、出力 端子1Bは"H"レベルに、出力端子1Aは"L"レベ

【0033】 つまり、バイアス電流 i1, i2 の交互切 り換えにより電機子コイルL1に流れる電流の方向を切 り換えてモータを回転させる。ここまでの動作は、従来 例と同じである。すなわち、バイアス電流 i1, i2の 交互切り換えによって、一方の対をなす出力上側スイッ チング素子Q11および出力下側スイッチング素子Q1 2をONにしかつ他方の対をなす出力上側スイッチング 素子Q21および出力下側スイッチング素子Q22をO FFにする状態と、前記一方の対をなす出力上側スイッ チング素子Q11および出力下側スイッチング素子Q1

8

チング素子Q21および出力下側スイッチング素子Q2 2をONにする状態とを交互に切り換えることにより、 電機子コイルL1に対してコイル電流を正方向に流す状 態と逆方向に流す状態とを交互に切り換えてモータを回 転させるように構成してある。

【0034】次に、従来例で問題となっていた両バイア ス電流 i_1 , i_2 がともに出力されない期間 t_1 , t_2 の動作について説明する。

【0035】③ 期間t₁での動作

この期間 \mathbf{t}_1 は、バイアス電流 \mathbf{i}_1 の立ち下がりからバ $\mathbf{10}$ 期間 \mathbf{t}_2 に入る前の状態では、スイッチング素子Q $\mathbf{2}$ イアス電流 i2 の立ち上がりまでである。この期間 t1 に入る前の状態では、4つの出力スイッチング素子Q1 1, Q12, Q21, Q22のうち、スイッチング素子 Q11, Q12がONで、スイッチング素子Q21, Q 22がOFFであり、回転特性安定化回路30における スイッチング素子Q32のOFFのためにPNP型のス イッチング素子Q23はOFFとなっており、回転特性 安定化回路40におけるスイッチング素子Q42のON のためにPNP型のスイッチング素子Q13はONとな っている。

【0036】期間 t1の開始初期にバイアス電流 i1が 立ち下がるとスイッチング素子Q14がOFFするた め、スイッチング素子Q15, Q16もOFFし、出力 下側スイッチング素子Q12がOFF状態となる。

【0037】しかし、スイッチング素子Q14のOFF によって回転特性安定化回路30におけるスイッチング 素子Q31がOFFし、スイッチング素子Q32が定電 流源50によってONする。その結果、PNP型のスイ ッチング素子Q23のベースがスイッチング素子Q32 によりバイアスされて "L" レベルとなり、このスイッ チング素子Q23がONとなり、それまでOFF状態で あった出力上側スイッチング素子Q21がON状態とな る。

【0038】なお、スイッチング素子Q42がON状態 を保持するため、スイッチング素子Q13のON状態ひ いては出力上側スイッチング素子Q11のON状態も変 わらない。出力下側スイッチング素子Q22もOFF状 態を保つ。

【0039】以上をまとめると、出力端子1Aの上下に あるスイッチング素子Q11がON、スイッチング素子 Q22がOFFで、かつ、出力端子1Bの上下にあるス イッチング素子Q21がOFF、スイッチング素子Q1 2がONの状態から、バイアス電流i₁の立ち下がりの タイミングで、出力端子1A,1Bの上側のスイッチン グ素子Q11,Q21がともにONで、下側のスイッチ ング素子Q22, Q12がともにOFFの状態に切り換 わる。

【0040】すなわち、出力下側スイッチング素子Q2 2のON状態からOFF状態への反転を回転特性安定化 回路40が検出して、それまでOFF状態であった出力 50

上側スイッチング素子Q11をON状態に反転する。そ のため、電機子コイルL1にコイル電流が流れなくなっ て逆起電力が発生しても、出力端子1A, 1Bは、ON となった上側の2つのスイッチング素子Q11, Q21 を介して直流電源Vccと短絡するので、出力端子1Aが 図2で鎖線で示すようにグランドGNDの電位よりも下 回るということから免れ、寄生トランジスタの発生が回 避される。

【0041】 **④** 期間 t₂ での動作

1, Q22がONで、スイッチング素子Q11, Q12 がOFFであり、PNP型のスイッチング素子Q13は OFF、スイッチング素子Q23はONとなっている。 【0042】バイアス電流i2が立ち下がるとスイッチ ング素子Q24がOFFし、出力下側スイッチング素子 Q22がOFF状態となる。

【0043】しかし、スイッチング素子Q24のOFF によって回転特性安定化回路40におけるスイッチング 素子Q42がONするので、PNP型のスイッチング素 20 子Q13がONとなり、それまでOFF状態であった出 力上側スイッチング素子Q11がON状態となる。

【0044】なお、出力上側スイッチング素子Q21の ON状態と出力下側スイッチング素子Q12のOFF状 態は保たれる。

【0045】以上をまとめると、出力端子1Aの上下に あるスイッチング素子Q11がOFF、スイッチング素 子Q22がONで、かつ、出力端子1Bの上下にあるス イッチング素子Q21がON、スイッチング素子Q12 がOFFの状態から、バイアス電流 i2 の立ち下がりの タイミングで、出力端子1A,1Bの上側のスイッチン グ素子Q11,Q21がともにONで、下側のスイッチ ング素子Q22,Q12がともにOFFの状態に切り換 わる。

【0046】すなわち、出力下側スイッチング素子Q1 2のON状態からOFF状態への反転を回転特性安定化 回路30が検出して、それまでOFF状態であった出力 上側スイッチング素子Q21をON状態に反転する。そ のため、電機子コイルL1にコイル電流が流れなくなっ て逆起電力が発生しても、出力端子1A,1Bは、ON となった上側の2つのスイッチング素子Q11、Q21 を介して直流電源Vccと短絡するので、出力端子1Bが 図2で鎖線で示すようにグランドGNDの電位よりも下 回るということから免れ、寄生トランジスタの発生が回 避される。

【0047】以上の30, 40のように期間 t₁, t₂ のい ずれにおいても、電機子コイルL1にコイル電流が流れ なくなって逆起電力が発生するが、出力端子1A,1B は、ONとなった上側の2つのスイッチング素子Q1 1, Q21を介して直流電源Vccと短絡するのでグラン ドGNDの電位よりもトランジスタのコレクタ・エミッ

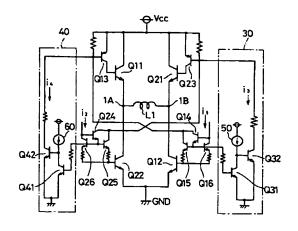
タ間電圧VCBだけ高い電位となる。したがって、ICの内部に寄生トランジスタが発生することを防止することができ、その分だけ、モータの回転数ートルク特性を安定したものとでき、回転むらをなくしてモータを滑らかに回転させることができる。

【0048】なお、出力下側スイッチング素子Q22 (Q12)がON状態からOFF状態に反転したときに出力端子1A(1B)でつながっている出力上側スイッチング素子Q11(Q21)をOFF状態からON状態に反転させるのに、上記実施例ではスイッチング素子Q1026(Q16)のベース電圧が"H"レベルから"L"レベルに反転することをスイッチング素子Q41(Q31)で検出するように構成したが、スイッチング素子Q24(Q14)のベース電圧の"H"レベルから"L"レベルへの反転で検出しても同じことであり、この場合はスイッチング素子Q41(Q31)のベースをスイッチング素子Q24(Q14)のベースに接続すればよい。

[0049]

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、電機子 20 コイルに流れる電流の方向を切り換えるに際して4つすべてのスイッチング素子が同時にOFFになる状態を避け、下側スイッチング素子がON状態からOFF状態に反転したときに、その反転の検出に基づいてそれまでOFF状態にあった方の上側スイッチング素子をON状態

【図1】



に反転するように構成したので、コイル電流の遮断に伴って電機子コイルに逆起電力が発生しても出力端子がグランド電位よりも下回ることを回避して寄生トランジスタの発生を阻止できる。したがって、その分だけ、モータの回転数ートルク特性を安定したものとでき、回転むらをなくしてモータを滑らかに回転させることができる。

10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るモータ駆動回路を示す) 回路図である。

【図2】実施例の動作説明に供するタイミングチャートである。

【図3】従来例に係るモータ駆動回路を示す回路図である。

【図4】従来例の動作説明に供するタイミングチャート である。

【符号の説明】

L1 電機子コイル

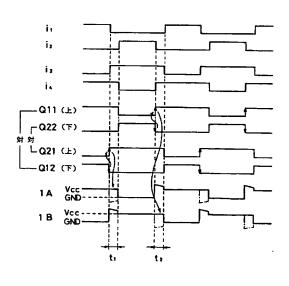
1A,1B 出力端子

Q11,Q12 一方の対をなす上側スイッチング素子および下側スイッチング素子

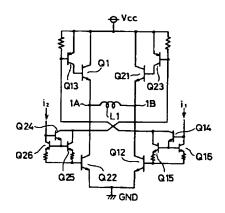
Q21, Q22 他方の対をなす上側スイッチング素子および下側スイッチング素子

30,40 回転特性安定化回路

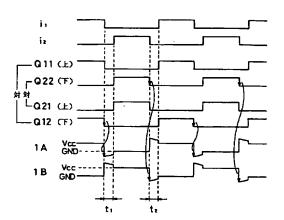
【図2】



【図3】



【図4】



【手続補正書】

【提出日】平成3年11月20日

【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図3

【補正方法】変更

【補正内容】

【図3】

